

ULTRAFAST SOFT RECOVERY RECTIFIER DIODE

PRODUCT APPLICATIONS

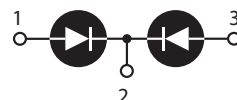
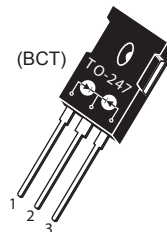
- Anti-Parallel Diode
 - Switchmode Power Supply
 - Inverters
- Free Wheeling Diode
 - Motor Controllers
 - Converters
 - Inverters
- Snubber Diode
- PFC

PRODUCT FEATURES

- Ultrafast Recovery Times
- Soft Recovery Characteristics
- Popular TO-247 Package
- Low Forward Voltage
- Low Leakage Current
- Avalanche Energy Rated

PRODUCT BENEFITS

- Low Losses
- Low Noise Switching
- Cooler Operation
- Higher Reliability Systems
- Increased System Power Density



- 1 - Anode 1
 2 - Common Cathode
 Back of Case - Cathode
 3 - Anode 2

MAXIMUM RATINGS

 All Ratings per leg: $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

Symbol	Characteristic / Test Conditions	APT30DQ120BCT(G)	UNIT
V_R	Maximum D.C. Reverse Voltage	1200	Volts
V_{RRM}	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage		
V_{RWM}	Maximum Working Peak Reverse Voltage		
$I_{F(AV)}$	Maximum Average Forward Current ($T_C = 103^\circ\text{C}$, Duty Cycle = 0.5)	30	Amps
$I_{F(RMS)}$	RMS Forward Current (Square wave, 50% duty)	43	
I_{FSM}	Non-Repetitive Forward Surge Current ($T_J = 45^\circ\text{C}$, 8.3ms)	210	
E_{AVL}	Avalanche Energy (1A, 40mH)	20	mJ
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Temperature Range	-55 to 175	$^\circ\text{C}$
T_L	Lead Temperature for 10 Sec.	300	

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions		MIN	TYP	MAX	UNIT
V_F	Forward Voltage	$I_F = 30\text{A}$		2.8	3.3	Volts
		$I_F = 60\text{A}$		3.4		
		$I_F = 30\text{A}, T_J = 125^\circ\text{C}$		2.1		
I_{RM}	Maximum Reverse Leakage Current	$V_R = 1200\text{V}$			100	μA
		$V_R = 1200\text{V}, T_J = 125^\circ\text{C}$			500	
C_T	Junction Capacitance, $V_R = 200\text{V}$			36		pF

DYNAMIC CHARACTERISTICS

APT30DQ120BCT(G)

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 1A$, $di_F/dt = -100A/\mu s$, $V_R = 30V$, $T_J = 25^\circ C$	-	26		ns
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 30A$, $di_F/dt = -200A/\mu s$ $V_R = 800V$, $T_C = 25^\circ C$	-	320		
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		-	545		nC
I_{RRM}	Maximum Reverse Recovery Current		-	4	-	Amps
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 30A$, $di_F/dt = -200A/\mu s$ $V_R = 800V$, $T_C = 125^\circ C$	-	435		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		-	2100		nC
I_{RRM}	Maximum Reverse Recovery Current		-	9	-	Amps
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 30A$, $di_F/dt = -1000A/\mu s$ $V_R = 800V$, $T_C = 125^\circ C$	-	180		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		-	2975		nC
I_{RRM}	Maximum Reverse Recovery Current		-	28		Amps

THERMAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JC}$	Junction-to-Case Thermal Resistance			.80	$^\circ C/W$
W_T	Package Weight		0.22		oz
			5.9		g
Torque	Maximum Mounting Torque			10	lb•in
				1.1	N•m

Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

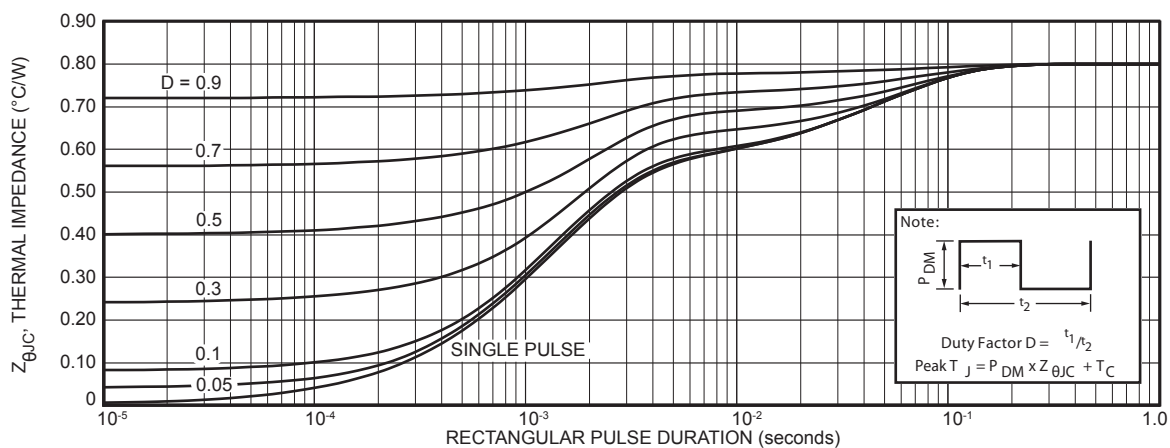


FIGURE 1. MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs. PULSE DURATION

TYPICAL PERFORMANCE CURVES

APT30DQ120B_S(G)

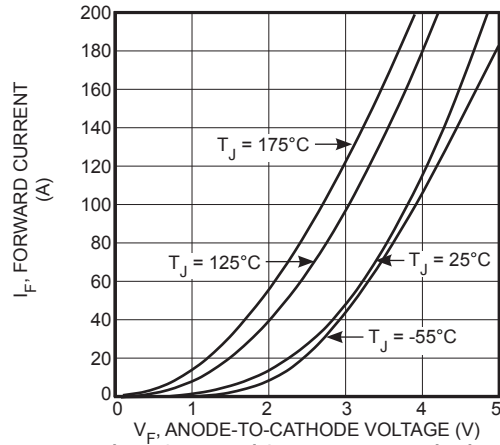


Figure 2. Forward Current vs. Forward Voltage

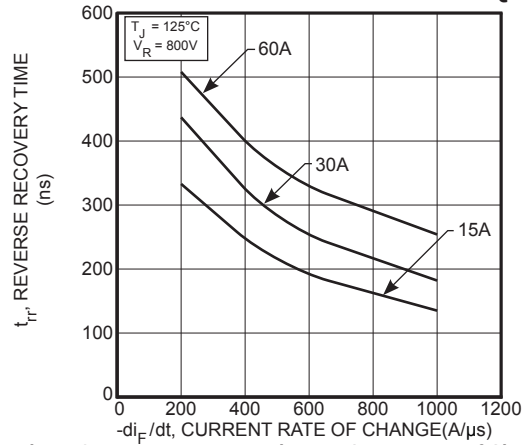


Figure 3. Reverse Recovery Time vs. Current Rate of Change

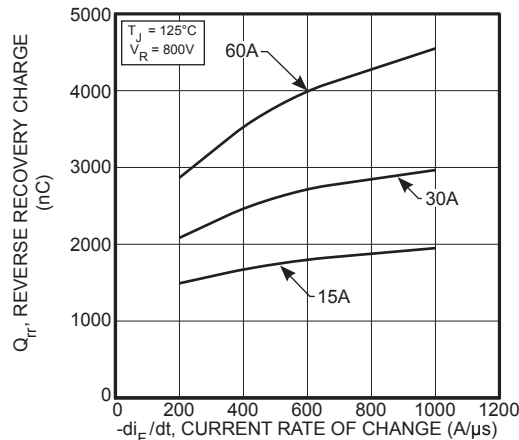


Figure 4. Reverse Recovery Charge vs. Current Rate of Change

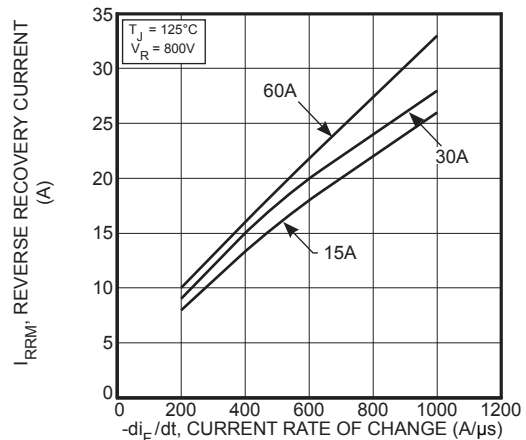


Figure 5. Reverse Recovery Current vs. Current Rate of Change

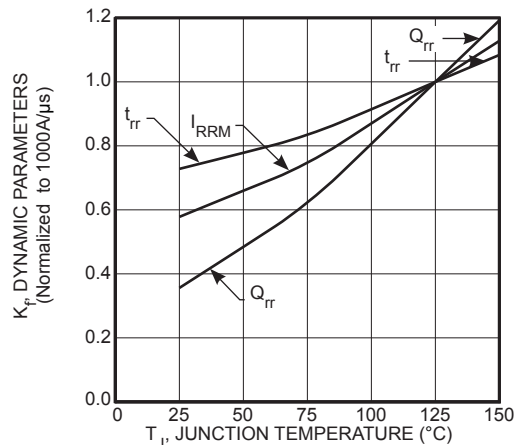


Figure 6. Dynamic Parameters vs. Junction Temperature

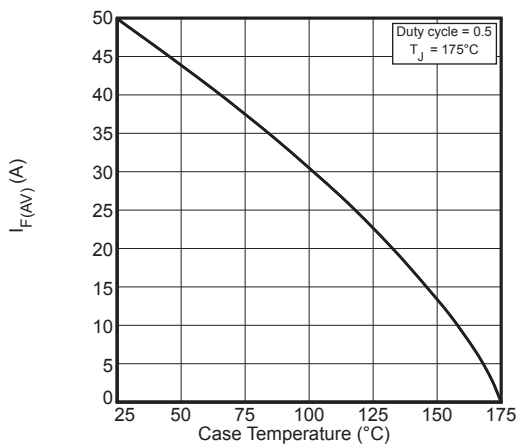


Figure 7. Maximum Average Forward Current vs. Case Temperature

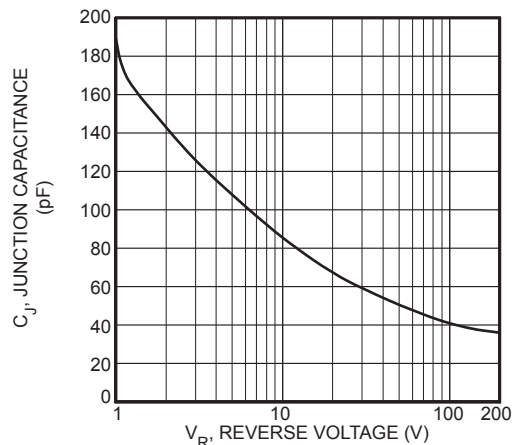


Figure 8. Junction Capacitance vs. Reverse Voltage

- 1 I_F - Forward Conduction Current
- 2 di_F/dt - Rate of Diode Current Change Through Zero Crossing.
- 3 I_{RRM} - Maximum Reverse Recovery Current
- 4 t_{rr} - Reverse Recovery Time, measured from zero crossing where the diode current goes from positive to negative, to the point at which the straight line through I_{RRM} and $0.25 I_{RRM}$ passes through zero.
- 5 Q_{rr} - Area Under the Curve Defined by I_{RRM} and t_{rr} .

053-4245 Rev B 3-2011



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331